

# Hochreiner Ptfе-Wafer-Reinigungskorb Säurebeständiger Siliziumwafer-Träger Fluoropolymer-Ätzkorb

Artikelnummer: PL-CP284



## Einführung

Gewährleisten Sie kontaminationsfreie Halbleiterprozessierung mit unseren hochreinen PTFE-Wafer-Reinigungskörben. Diese für aggressives Ätzen und Reinigen konzipierten, anpassbaren Träger bieten außergewöhnliche chemische Beständigkeit und thermische Stabilität für die Handhabung von Siliziumwafern während kritischer Nasschemie-Herstellungsprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
<b>RCA-Standardreinigung</b>	Sequenzielle SC-1- und SC-2-Reinigungsschritte zur Entfernung organischer Rückstände und metallischer Verunreinigungen von Siliziumwafern.	Verhindert das Auswaschen metallischer Ionen und gewährleistet ultrareine Prozessumgebungen.
<b>Piranha-Ätzen</b>	Verwendung von Schwefelsäure- und Wasserstoffperoxid-Gemischen zur Entfernung schwerer organischer Materialien und Fotolack.	Widersteht extremen exothermen Reaktionen und aggressiver Oxidation ohne Degradation.
<b>HF-Tauch-/Ätzbad</b>	Entfernung von Opferoxid-Schichten oder nativen Oxiden mittels Flusssäurelösungen.	Vollständige Immunität gegen HF-Angriff, der Glas- oder Quarzträger zerstören würde.
<b>Solarzellen-Texturierung</b>	Eintauchen von Siliziumwafern in alkalische oder saure Lösungen zur Erzeugung lichtfangender Oberflächentexturen.	Hoher Durchsatz und Beständigkeit gegen konzentrierte KOH- oder NaOH-Lösungen.
<b>Post-CMP-Reinigung</b>	Entfernung von Slurry-Partikeln und chemischen Rückständen nach dem Chemisch-Mechanischen Polieren (CMP).	Antihaft-Oberfläche verhindert die Wiederablagerung von Slurry auf Träger und Wafern.
<b>Fotolithografie</b>	Entwicklungs- und Stripping-Schritte unter Einbeziehung aggressiver organischer Lösungsmittel und Entwickler.	Lösungsmittelbeständige Konstruktion gewährleistet kein Quellen oder Erweichen des Trägermaterials.
<b>Ultraschallreinigung</b>	Hochfrequente akustische Reinigung empfindlicher elektronischer Komponenten in wässrigen Lösungen.	Überträgt Ultraschallenergie effektiv und schützt Komponenten vor mechanischem Aufprall.
<b>GaAs-Prozessierung</b>	Nasschemisches Ätzen und Reinigen von Verbindungshalbleitersubstraten für die Optoelektronik.	Sanfte, sichere Unterstützung für spröde Substrate während kritischer Fertigungsschritte.

Parameter	Beschreibung / Spezifikation (PL-CP284 Serie)
<b>Produktartikelnummer</b>	PL-CP284
<b>Primärmaterial</b>	Hochreines reines PTFE (Polytetrafluorethylen)
<b>Chemische Kompatibilität</b>	Universell (Starke Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Oxidationsmittel)
<b>Standard-Wafergrößen</b>	Kompatibel mit 4-Zoll-, 6-Zoll- und 8-Zoll-Wafern
<b>Anpassungsoptionen</b>	Vollständig anpassbare Abmessungen, Schlitzanzahlen und Schlitzbreiten
<b>Griffkonfigurationen</b>	Feste, abnehmbare oder roboter-kompatible Stile (Anpassbar)
<b>Betriebstemperatur</b>	-200°C bis +260°C (Dauerbetrieb)
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Hochpräzisions-CNC-gefräst, niedrigporöse Oberfläche

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Beschreibung / Spezifikation (PL-CP284 Serie)	
Schlitzdesign	V-Form oder kundenspezifische Profile für minimale Kontaktfläche	
Fertigungsprozess	100% CNC-gefräst für Präzision und strukturelle Integrität	
Reinheitsgrad	Spurenanalysegrad, metallfreie Fertigung	